

IEEE EDS 第 22 回 関西コロキウム電子デバイスワークショップのお知らせ

IEEE EDS Kansai Chapterの皆様
IEEE Kansai Section の皆様

2022年8月31日
IEEE EDS Kansai Chapter Chair 渡辺 博文
Vice Chair 木村 睦

下記の通り、第22回「関西コロキウム電子デバイスワークショップ」を開催致します。
このワークショップは毎年国際会議での発表講演、または主要ジャーナルに掲載された論文の中から
関西とその近隣に拠点を置く大学・企業等の研究者による発表を抽出・厳選して、投稿と同じ内容を
日本語で講演して頂くものです。今年も昨年につき、オンラインでの開催となりました。
皆様のご参加をお待ち申し上げます。

記

会議名: 第22回「関西コロキウム電子デバイスワークショップ」
主 催: IEEE Electron Devices Society Kansai Chapter
日 時: 2022年10月7日(金) 10:00~15:35
会 場: オンライン(Zoom)

プログラム: 次ページ以降参照
公用語: 日本語 (一部英語)
参加資格: 特になし (事前登録必要)
会 費: 無料

申し込み方法:

参加希望者は、9/30までに 以下の Google フォームからお申込みください。

<https://forms.gle/v568wu62bioAUuCd6>

Google Formが使えない方は、お手数ですが、以下の問い合わせ先にメールで直接
お申込みください。

申込者には、開催日の1週間くらい前に Zoom URL 情報をメールにて連絡します。

その他:

詳細は IEEE EDS 関西チャプタの HP をご覧ください。

<http://www.ieee-jp.org/section/kansai/chapter/eds/>

[お問い合わせ先]

IEEE EDS Kansai Chapter Secretary: 安藤友一 (株)リコー; yuichi.ando (at) jp.ricoh.com)

=====

<ご講演頂く皆様へ>

講演時間: 20分 + 質疑: 5分 (日本語。一部英語)

使用器具: 当日はZoomを使用します。接続用PCのご準備をよろしく願いいたします。

開会挨拶 [10:00 - 10:05]

渡辺 博文 (W. T. C.)

Session I. Sensors, MEMS, and BioMEMS [10:05-10:55]

座長：村上 修一 (大阪産業技術研究所)

**HIGHLY ACCURATE MEASUREMENT OF TRANS-EPITHELIAL
ELECTRICAL RESISTANCE IN ORGAN-ON-A-CHIP [MEMS Conference]**

Takashi Miyazaki, Jiandong Yang, Satoshi Imamura, Yoshikazu Hirai,
Ken-ichiro Kamei, Toshiyuki Tsuchiya, Osamu Tabata
Kyoto University

A Multi-Functional Module-Based Capsule Robot [IEEE Sensors Journal]

Lingling Zheng, Shuxiang Guo, Zixu Wang, Takashi Tamiya
Kagawa University

Session II. CMOS Process, Device, and Circuit [10:55-11:45]

座長：茂庭 昌弘 (東京工科大学)

**Evaluation methodology for assessment of dielectric degradation and
breakdown dynamics using time dependent impedance spectroscopy (TDIS)
[IEEE IRPS]**

*Tomohiro Kuyama, Keiichiro Urabe, and Koji Eriguchi
Kyoto University (*currently, TOKYO ELECTRON MIYAGI Ltd.)

**Amorphous-Metal-Oxide-Semiconductor Thin-Film Planar-Type Spike-Timing
Dependent-Plasticity Synapse Device [IEEE EDL]**

Yuki Shibayama, Yuki Ohnishi, Tetsuya Katagiri, Yuhei Yamamoto,
Yasuhiko Nakashima, Mutsumi Kimura
Ryukoku University

— 休憩 [11:45-13:00] —

Session III. Power and Compound Semiconductor Devices [13:00-13:50]

座長：加藤 貴敏 (株式会社 村田製作所)

**Improvement of Both n- and p-Channel Mobilities in 4H-SiC MOSFETs by
High-Temperature N₂ Annealing [IEEE TED]**

Keita Tachiki, Tsunenobu Kimoto
Kyoto University

**Gate Oxide Instability against a Wide Range of Negative Electric Field Stress
of SiC MOSFETs [IEEE IEDM]**

M. Noguchi, A. Koyama, T. Iwamatsu, H. Watanabe, N. Miura
Mitsubishi Electric Corporation

— 休憩 [13:50-14:00] —

Session IV. Optoelectronics, Displays, and Imagers [14:00-15:15]

座長：浦岡 行治（奈良先端科学技術大学院大学）

High mobility hydrogenated indium oxide thin-film transistors (InO_x:H TFTs) formed by low-temperature solid phase crystallization[SSDM]

Taiki Kataoka, and Mamoru Furuta
Kochi University of Technology

Fully Solution-Processed Self-Aligned Amorphous InZnO Thin-Film Transistors by Continuous Wave Green Laser Irradiation [SSDM]

Dianne C. Corsino, Juan Paolo S. Bermundo, Muhammad Arif Razali, Mutsunori Uenuma, Yukiharu Uraoka
Nara Institute of Science and Technology

Comparison of switching TFT operation in output frequency dependence of the artificial retina using LTPS-TFT [AMFPD]

Kohei Toyoda, Naoya Naitou, Ryota Ichikawa, Masamaka Mori, Mutsumi Kimura
Ryukoku University

AWARD授与 [15:15-15:30]

佐藤 伸吾（関西大学）

閉会挨拶 [15:30-15:35]

上田 尚宏（日清紡マイクロデバイス株式会社）